# 2SA1115

低周波增幅用 シリコンPNPエピタキシァル形

### 概要

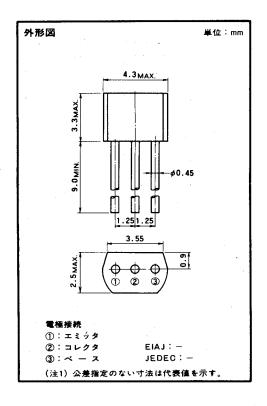
2SA1115は、樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシァル形トラ ンジスタで、低周波の電圧増幅用として設計、製造されておりま す。コレクタ電流が大きく、かつ直流電流増幅率の直線性が良い ので、幅広い用途に御使用いただける汎用トランジスタです。ま た特に混成集積回路などの高密度実装用に適するよう外形を小さ くしています。

### 特 長

- ●直流電流増幅率の直線性が良い
- ●コレクタ飽和電圧が低い
- V<sub>CE(sat)</sub> = -0.3V 最大、(@I<sub>C</sub>=-100mA、I<sub>B</sub>=-10mA)
- ●外形が小さい

### 用途

小形機器の低周波電圧増幅用



## 最大定格(Ta=25℃)

紀号	項目	定格値	単位
Vcво	コレクタ・ベース間電圧	-50	V
VEBO	エミッタ・ベース間電圧	-6	V
VCEO	コレクタ・エミッタ間電圧	<b>-50</b>	V
Ic	コレクタ電流	-200	mA
Pc	コレクタ損失(Ta=25℃)	300	mW
Τj	接合部温度	125	τ
Tstg	保存温度 -	-55~+125	τ

### 電気的特性(Ta=25℃)

		測 定 条 件	特 性 値			単位
記号	項目		最小	標準	最大	<b>→</b> 14
V(BR)CEO	コレクタ・エミッタ降伏電圧	I <sub>C</sub> =-100μA, R <sub>BE</sub> =∞	-50			V
Ісво	コレクタしゃ断電流	V <sub>CB</sub> =-50V, 1 <sub>E</sub> =0			-0.1	μΑ
I <sub>EBO</sub>	エミッタしゃ断電流	V <sub>EB</sub> =-6V, I <sub>C</sub> =0			-0.1	μΑ
h <sub>FE</sub> †	直流電流増幅率	$V_{CE} = -6V$ , $I_C = -1mA$	90		800	
h <sub>FE</sub>	直流電流増幅率	V <sub>CE</sub> =-6V, I <sub>C</sub> =-0.1mA	50			
VcE(sat)	コレクタ・エミッタ飽和電圧	I <sub>C</sub> =-100mA, I <sub>B</sub> =-10mA			-0.3	٧
f <sub>T</sub>	利得帯域幅積	V <sub>CE</sub> = -6V, I <sub>E</sub> = 10mA		200		MHz
Cob	コレクタ出力容量	$V_{CB} = -6V$ , $I_E = 0$ , $f = 1 MHz$		6,5		ρF
NF	雑音指数	$V_{OE} = -6V$ , $I_{E} = 0.3 \text{mA}$ , $f = 100 \text{Hz}$ , $R_{G} = 10 \text{k}\Omega$			20	d₿

†:hFEの値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	D	E	F	G	
h FE	90~180	150~300	250~500	400~800	